

Communiqué de presse

KIOXIA lance l'expédition d'échantillons de ses dispositifs TLC 1 Tb BiCS FLASH™ de 9^e génération

Ces nouveaux dispositifs intègrent des technologies de cellules mémoires existantes à une technologie CMOS avancée afin d'optimiser l'efficacité des investissements

Düsseldorf, Allemagne, 6 août 2026 – [KIOXIA Europe GmbH](#), leader mondial des solutions mémoire, a annoncé que KIOXIA Corporation avait lancé l'expédition d'échantillons de dispositifs mémoire TLC (Triple-Level Cell, cellule à triple niveau) de 1 Tb (téraoctet) intégrant sa technologie de mémoire flash 3D BiCS FLASH™ de 9^e génération^[1]. Ces dispositifs sont conçus pour répondre aux besoins d'applications telles que les PC et smartphones intégrant des fonctionnalités d'IA, offrant des capacités de stockage faibles à moyennes tout en nécessitant des performances élevées.

KIOXIA poursuit une stratégie reposant sur deux axes, fondée sur sa technologie innovante CMOS directement liée à la matrice (CBA)^[2] et OPS (On-Pitch Select Gate Drain)^[3]. Dans le cadre de sa stratégie unique reposant sur deux axes, KIOXIA fait progresser simultanément deux gammes de produits distinctes : ses solutions de 9^e génération, qui combinent hautes performances et optimisation des investissements, et sa technologie de 10^e génération, qui exploite un empilement avancé des couches pour offrir une capacité très élevée et des performances supérieures.

Les nouveaux dispositifs BiCS FLASH™ TLC de 1 Tb de 9^e génération, développés grâce à un procédé d'empilement de 230 couches basé sur la technologie BiCS FLASH™ de 8^e génération et une technologie CMOS avancée, affichent une vitesse d'interface NAND de 4,8 Gb/s, soit une

progression de 33 % par rapport aux dispositifs de 8^e génération, tout en offrant des performances comparables à celles des dispositifs de 10^e génération^[4].

Guidée par sa mission consistant à « contribuer à l'essor du monde grâce à la "mémoire" », KIOXIA reste déterminée à stimuler l'innovation technologique, à renforcer ses partenariats à l'échelle mondiale et à fournir des solutions de stockage avancées qui alimentent les infrastructures d'IA modernes.

#

Remarques :

1 : Ces échantillons sont destinés à la vérification de leur fonctionnement. Les spécifications définitives des produits fabriqués en série peuvent différer.

2 : Technologie permettant de fabriquer séparément chaque wafer CMOS et chaque tranche de matrice mémoire dans des conditions optimisées pour chacune d'elles, avant de les assembler par liaison. Cette technologie est utilisée depuis les produits BiCS FLASH™ de 8^e génération.

3 : Technologie permettant de raccourcir les lignes de bits et de réduire la capacité des lignes de mots en supprimant les trous de mémoire inutilisés. Cette technologie est utilisée depuis les produits BiCS FLASH™ de 8^e génération.

4 : La valeur de 1 Gb/s correspond à 1 000 000 000 bits par seconde. Cette valeur a été obtenue dans un environnement de test spécifique chez KIOXIA Corporation. Les résultats peuvent varier en utilisation réelle en fonction des conditions d'utilisation.

La densité du produit est déterminée en fonction de la densité des puces mémoires qu'il contient, et non de la capacité de mémoire disponible pour le stockage des données de l'utilisateur final. La capacité réellement disponible pour l'utilisateur sera inférieure en raison de l'espace réservé aux données supplémentaires, du formatage, des blocs défectueux et d'autres contraintes. Elle peut également varier selon le périphérique hôte et l'application utilisée. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux spécifications du produit concerné. 1 Go = 2^{30} bytes = 1 073 741 824 bytes.

Les vitesses de lecture et d'écriture indiquées correspondent aux meilleures valeurs obtenues dans un environnement de test spécifique de l'entreprise. KIOXIA Corporation ne garantit pas que les mêmes vitesses de lecture et d'écriture seront obtenues sur chaque dispositif individuel. Celles-ci peuvent varier en fonction du dispositif utilisé.



Les noms de sociétés, de produits et de services mentionnés peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

À propos de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de mémoires flash et de disques SSD (Solid State Drive). De l'invention de la mémoire flash NAND à la célèbre mémoire flash 3D BiCS FLASH™ d'aujourd'hui, KIOXIA continue de proposer des solutions en matière de mémoire et des services innovants qui enrichissent la vie des gens et élargissent les horizons de la société. La technologie innovante de mémoire flash 3D BiCS FLASH™ de l'entreprise façonne l'avenir du stockage dans les applications haute densité, notamment les smartphones avancés, les PC, les systèmes automobiles, les centres de données et les systèmes d'IA générative.

Visitez notre [site Web KIOXIA](#)

Coordonnées pour la publication :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél. : +49 (0)211 368 77-0

E-mail : KIE-support@eu.kioxia.com

Coordonnées pour les demandes de nature rédactionnelles :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél. : +49 (0) 211 36877 382

E-mail : lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Publié par :

Birgit Schöninger, Pretzl GmbH

Tél. : +49 (0)172 617 8431

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com

Site Web : www.pretzl.com